Облікова картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0206U004820

Державний реєстраційний номер: 0103U003788

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 20-03-2006

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Дослідження фотоелектричного інжекційно-плазмового підсилення в компенсованих напівпровідниках

Початок етапу: 01.2002

Закінчення етапу: 12.2005

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Наукова частина

Код за ЄДРПОУ: 02071091

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (0482) 23-84-17

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський Політехнічний Інститут"

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги 37, м. Київ, Київ, 03056, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0442048428

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Дослідження фотоелектричного інжекційно-плазмового підсилення в компенсованих напівпровідниках

Назва роботи англійською:

The investigation of the photoelectric injection -plasm am plicication in compensated semi- conductors

Реферат українською:

Об"єкт дослідження-інжекційні структури на базі викоомних напівпровідників (Ge, Si, AlGaAs) Мета роботи-розробити концепці фотоелектричного іжекційного підсилення в компенсованих напівпровіниках кціного пдсилення в компенсованих напівпровідниках. Запропоновано фізичні механыіми струмопереносу при безпосередньому впливі світла на рухливыіть носіїв заряду. Фотоелектричні характеристики варизонних та поверхнево-бар"єрних струтур залежать від магнітного поля, тиску. Розроблено лабораторні моделі датчиків світла, магнітного поля, тиску

Реферат англійською:

The object of research injector frames on the basis is high of semiconductors (Ge, Si, AlGaAs). The purpose of activity to work out a concept of photoelectric injected strengthening in compensated semiconductors. The physical gears carry of a current are offered at direct influencing of light on motility of charge carriers. The photoelectric characteristics injected gradet and superficially - barrier frames depend on a magnetic field, pressure. The models of sensors of light, magnetic field, pressure are designed5635

Індекс УДК: 53, 621.382

Коди тематичних рубрик: 29.01.05

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Курмашев Ш.Д.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Сминтина Валентин Андрійович

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

